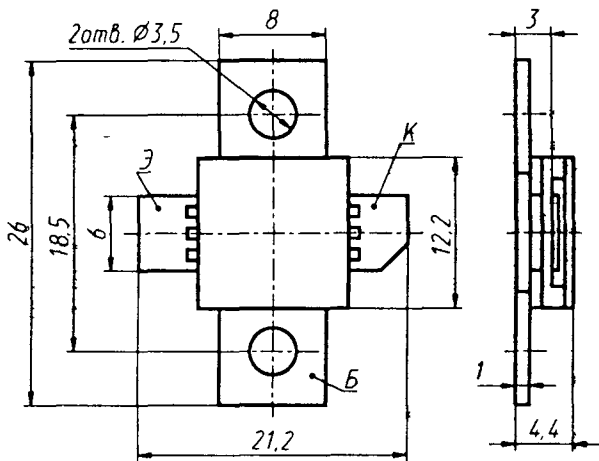


Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* генераторный. Предназначен для применения в широкополосных усилителях мощности, умножителях частоты и автогенераторах в схеме с общей базой в диапазоне частот 0,7...1,4 ГГц при напряжении питания 28 В в непрерывном

режиме и 35...40 В в импульсном режиме. Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Внутри корпуса имеются двухзвенные LC-звенья на входе и выходе транзистора. Тип прибора указывается на корпусе. Допускается нанесение маркировки в этикетке, а также на упаковочной таре, при этом маркировка на транзистор не наносится.

Масса транзистора не более 5 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



**Электрические параметры**

Выходная мощность на $f = 1,3$ ГГц при $U_{КБ} = 28$ В, $K_{УР} = 6$ дБ, не менее .....	50 Вт
типичное значение .....	55 Вт
Выходная мощность на $f = 1,3$ ГГц при $U_{КБ} = 20$ В, $K_{УР} = 4$ дБ, не менее .....	30 Вт
Коэффициент полезного действия коллектора на $f = 1,3$ ГГц при $U_{КБ} = 28$ В, $K_{УР} = 6$ дБ, не менее .....	45%
типичное значение .....	50%
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 50$ В, не более .....	100 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 3,5$ В, не более .....	30 мА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база <sup>1</sup>	
при $T_K = -60...+25\text{ }^\circ\text{C}$ .....	50 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	3,5 В
Потенциал статического электричества .....	1000 В
Постоянный ток коллектора .....	5 А
Импульсный ток коллектора:	
при $t_{и} = 20\text{ мкс}$ , $Q = 10$ .....	10 А
при $t_{и} = 1000\text{ мкс}$ , $Q = 10$ или $t_{и} = 500\text{ мкс}$ , $Q = 5$ .....	7 А
Постоянный ток базы .....	2 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора <sup>2</sup>	
в динамическом режиме при $T_K = +25\text{ }^\circ\text{C}$ .....	75 Вт
Температура $p$ - $n$ перехода .....	+175 $^\circ\text{C}$
Тепловое сопротивление переход—корпус .....	2 $^\circ\text{C}/\text{Вт}$
Температура окружающей среды .....	-60... $T_K =$ = +125 $^\circ\text{C}$

<sup>1</sup> При понижении температуры корпуса от +25 до -60  $^\circ\text{C}$   $U_{кб, макс}$  снижается линейно до 45 В.

<sup>2</sup> При  $T_K > +25\text{ }^\circ\text{C}$  максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к, ср, макс} = (175 - T_K)/2, \text{ Вт.}$$

При работе транзистора в импульсном режиме при  $t_{и} = 1000\text{ мкс}$ ,  $Q = 10$  или  $t_{и} = 500\text{ мкс}$ ,  $Q = 5$  напряжение питания должно быть не более 35 В, при  $t_{и} = 20\text{ мкс}$ ,  $Q = 10$  не более 40 В.

Применение транзистора в статическом режиме, в том числе в режиме класса «А» не допускается.

Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре паяльником. Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее 3 мм, температура припоя +260  $\pm$  10  $^\circ\text{C}$ , время пайки не более 3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 1 мм от корпуса, при этом температура пайки не должна превышать +150  $^\circ\text{C}$ . Допускается сварка выводов на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса, при этом температура корпуса не должна превышать +150  $^\circ\text{C}$ .